(Ni_{0.8}Zn_{0.2}Fe₂O₄)_{epoxy}-PZT 双层膜中的磁电效应*

张 茹¹) 王 森¹) 张 宁¹⁺ Srinivasan G^{1 (2)}
 1) 南京师范大学磁电子学实验室 ,南京 210097)
 2) 奥克兰大学物理系 ,罗切斯特 MI 48309, USA)
 (2005 年 10 月 20 日收到 2005 年 11 月 11 日收到修改稿)

讨论了 N_{i_{0.8}Zn_{0.2}Fe₂O₄(NZFO)与锆钛酸铅(PZT)的双层膜结构样品的磁电(ME)效应.NZFO 粉料由溶胶-凝胶法 制成 ,再经 900℃热压 ,并高温烧结.在该双层膜中测量到了很强的磁电相互作用.发现横向的磁电效应比纵向效应 大一个数量级 ,并且随 NZFO 烧结温度的提高而增加.当烧结温度从 950℃上升到 1380℃时 ,横向 ME 电压系数($\alpha_{\rm E}$) 的最大值变化范围为 25.6 mV Am⁻² ≤ $\alpha_{\rm E}$ ≤ 199.6 mV Am⁻².理论分析显示 NZFO-PZT 双层膜样品中 ME 效应源于 NZFO 与 PZT 之间相对良好的磁电耦合.}

关键词:镍铁氧体,PZT,热压法,ME效应 PACC:7550G,7760,7550

1.引 言

磁电(ME)效应材料由于可使能量在磁场和电 场中自由地转换而在传感器研制领域具有广阔的应 用前景,例如存储器、磁电传感器及磁电转换元件等 等.因此,半个世纪以来,磁电效应的研究一直受到 广泛关注.磁电效应的表现之一为磁场诱导的电介 质极化^[1],并以电压系数 $\alpha_{\rm E}(\alpha_{\rm E} = \delta E/\delta H)$ 反映 ME 效应的强弱.

ME 效应最先被在 Cr_2O_3 中观察到.其电压系数 $\alpha_{Emax} = 25 \text{mV} \text{Am}^{-2[2,3]}.随后人们又研究了 Ti_2O_3^{[4]},$ $GaFeO_3^{[5]},方硼石和磷酸盐的混和物^[6,7],固溶体$ $PbFe_{0.5}Nb_{0.5}O_3^{[8]</sub>及石榴石薄膜^{9,10]}等物质的磁电行$ 为.至今观察到大约 80 种单相材料具有 ME 效应^[11].在单相物质中 ,ME 效应的出现需要物质同时具有原子磁矩和电偶极子的长程有序 ,而自然界中满足该类条件的物质比较少 ,所以单相物质所具有 $的磁电效应的 <math>\alpha_E$ 数值都非常小.并且其中很多材 料的铁磁转变居里点远低于室温.这些缺陷成为 ME 效应技术应用的一大障碍.

为了更好的实现磁电耦合 ,van Suchtelen 等人建

近年来,为获得巨 ME 效应和超高的灵敏度, ME 效应的研究趋向 m 相和 p 相材料的多层复合物 上,例如 Terfnol-D-Ph(Zr,Ti)O₃多层膜,实验获得到 了巨大的 ME 电压系数,α_{Emax}可达 6075 mV Am^{-2[16]}; 而由固相反应方法制备的 NZFO-PZT 双层膜和多层 膜,α_{Emax}也可达 56.3mV Am^{-2[17]}.层状结构样品与块 状合成物相比具有以下优点:1)单相的 p 相材料易 于被极化,并且单相压电材料的高阻特性可抑制漏 电流,从而增强了压电效应.2)在样品的制备过程 中,不易产生杂质相.因此,选择适当的 m 相材料和

^{*} 国家自然科学基金(批准号 20473038)和江苏省高技术计划基金(批准号 :BG-2005401)资助的课题.

[†] E-mail : zhangning@njnu.edu.cn

p相材料,并保证 m相材料和 p相材料良好的弹性 耦合是获得较高磁电效应的前提条件,也是须解决 的关键问题。

本文研究了热压法制备的 Ni_{0.8} Zn_{0.2} Fe₂O₄ (NZFO)与 Pb(Zr, Ti)O₃(PZT)结合形成的双层膜. 镍锌铁氧体由于其较高的机械强度和化学稳定性而 成为最常用的软铁介质,并由于其高阻特性和低的 涡流损耗而在高频电路、高质量滤波器、棒状天线及 高频变压器得到广泛使用^[18,19].这里 NZFO 被用做 为一种磁致伸缩材料.在镍铁氧体中参杂 Zn 会增强 多层膜中准压磁或 ME 耦合的强度^[20].PZT 是一种 已商品化的压电材料.二者通过环氧树脂或其他胶 黏剂结合.在偏置磁场的作用下,NZFO 层的磁致伸 缩导致了 PZT 压电效应.

2. 实 验

本文所用 NZFO 样品采用溶胶凝胶(sol-gel)方 法制备^[21]. 硝酸镍,硝酸锌及硝酸铁按化学配比称 量后混合制成水溶液,再加入适量聚乙稀醇(PVA) 胶体,持续搅拌并加热.加热温度通常不超过 80°C. 待 PVA 与上述水溶液的相界完全消失,即得 NZFO 溶胶.继续加热该溶胶至完全干燥而成凝胶.研磨所 得凝胶成粉状,并在 400℃下预烧 10h 后得样品前驱 粉体.然后将前驱体粉体压制成圆柱状,在 900℃下 热压(hot pressing)烧结 10h,再将其置于不同温度下 烧结.烧结温度(T_s)从 950℃到 1380℃.再经切片, 得 NZFO 薄片.

X 射线衍射显示如此制备的铁氧体 NZFO 样品 具有完好的尖晶石结构,空间群为 Fd_{3m} ,并不存在 任何杂相,见图 1 所示.另外,该铁氧体也显示了具 有高度的致密性及良好的磁性参数.样品的磁性测 量采用振动样品磁强计进行.磁性表征包括磁滞回 线(见图 2)及磁热曲线(见图 2 嵌图).图 2 显示使该 NZFO 磁化的饱和磁场大约为 40000e,铁磁—顺磁 转变温度 $T_e = 758K$.这与文献报道是符合的^[22].

3. 结果与讨论

双层膜的获得是先将购得的 PZT 粉料经热压, 切片,并通过固银法在其两个端面制备出电极.将制 备好的 PZT 圆片在 425K 温度下极化,并在垂直于样 品平面,强度约为 30—50kV/cm 的电场中冷却至室



图 1 Ni_{0.8}Zn_{0.2}FeO XRD 图片



图 2 Ni_{0.8}Zn_{0.2}FeO 磁性测量结果

温,然后与上述 NZFO 圆片黏结.我们采用过多种黏 结剂来制备双层膜.但实验显示以慢干型环氧树脂 (epoxy)为黏结剂具有最好的效果.

ME 效应的测量方法如下 :利用一对 Helmholz 线圈产生偏置磁场 *H*,交变磁场 *δH*的频率为 100Hz, *H*和*δH*相互平行.测量在室温下进行.对磁 场平行于样品表面和垂直于样品表面时的磁电效应 分别进行了测量,并分别将上述两种测量方式所得 到的 ME 电压系数记为(横向 ME 系数) $\alpha_{E.31}$ 及(纵向 ME 系数) $\alpha_{E.33}$.图 3 给出了不同烧结温度的 NZFO 与同一温度(1200℃)烧结的 PZT 结合形成的双层膜 的 $\alpha_{E.31}$ 的测量结果.

由图 3 可见,1) $a_{E,31}$ 随偏置磁场的变化出现一 峰值,而 $a_{E,31}$ 峰值所对应的磁场很小,只有 8kAm⁻¹ 左右.但随着 *H* 的进一步增加, $a_{E,31}$ 由峰值很快下 降,并当 *H* > 64kAm⁻¹时逐渐降至零.这说明 NZFO-PZT 双层膜中的 ME 耦合虽与磁致伸缩有关,但并 不完全随磁致伸缩变化.因为磁致伸缩与磁性层磁



图 3 不同烧结温度 NZFO-PZT 双层膜纵向 ME 系数随偏置磁场 的变化

化状态有关,磁化饱和时,磁致伸缩也趋于饱和;2) $\alpha_{E,31}$ 的峰值所对应的偏置磁场 H_{peak} 也随烧结温度的 提高而基本上呈单调上升.这意味着 NZFO 磁致伸 缩与样品的致密度有关.3)随烧结温度的提高, $\alpha_{E,31}$ 的峰值总体趋于提高,但并非单调提高.我们认 为,前者与样品中 NZFO 的致密度及晶化程度有关. 因为多晶体的致密度及晶化程度与烧结温度密切相 关.而后者是由于 NZFO 与 PZT 的弹性模量不一致, 从而导致双层膜的非线性形变.而压电系数与形变 之间的张量性质可以导致 $\alpha_{E,31}$ 随烧结温度的非单 调变化.

由 1380 °C 烧结的 NZFO 所形成的 NZFO-PZT 双 层膜显示了最大的 ME 效应.为进一步研究其特性, 我们测量了该双层膜的 $\alpha_{E.31}$ 及 $\alpha_{E.33}$ 随偏置磁场的 变化.其结果如图 4 所示.

图 4 显示磁场平行于样品表面时 ME 电压系数 $\alpha_{E.31}$ 比垂直情况下的 $\alpha_{E.33}$ 约大一个数量级. 当磁场 H = 17.12kAm⁻¹时 , $\alpha_{E.31}$ 可达 199.6 mV Am⁻².这一 数值是相同方法制备的 La_{0.7}Sr_{0.3} MnO₃-PZT 双层膜的 同类参数($\alpha_{Emax} = 62.5$ mV Am⁻²)的 3 倍 ;也是固相 反应方法制备的 NZFO-PZT 双层膜和多层膜的同类 参数的 3.5 倍^[17].

我们建立了一套理论模型用以解释双层膜样品 中的 ME 效应^[23].该合成物可被视为一种具有压电 层和磁致伸缩层的均匀介质.我们引进一个接触面 耦合系数 *k* 来考虑不能近似于理想化的层间耦合. 用弹性方程和静电方程来估算横向和纵向场中的



图 4 1380℃烧结 NZFO-PZT 双层膜的磁电效应理论与实验结果 的比较

ME 系数.该模型依赖于材料的磁致伸缩行为.事实 上磁致伸缩系数 λ 是反映 ME 耦合特性的重要磁性 参数.ME 耦合的强弱直接正比于压磁系数 q(q = $<math>\partial \lambda/\partial H$ 其中 H 为所加磁场强度).为此,我们测量了 1380℃烧结的 NZFO 样品的磁致伸缩系数随外磁场 的变化.这些数据是由标准张力计(应变片)获得的. 磁致伸缩系数 λ 的测量分别沿磁场平行于和垂直 于样品表面进行.并分别将两者记为 λ_{11} 及 λ_{12} .其结 果见图 5.可见,在 160kAm⁻¹磁场附近,磁致伸缩系 数 λ 基本达到饱和.



图 5 1380℃烧结 NZFO 样品的磁致伸缩系数 λ 随外磁场的变化

将材料的相关参数值及由图 5 中的 λ -*H* 值关系 得到的 q 代入该模型,可估计出只有 $a_{E,31}$ 具有可观 察到的输出,而 $a_{E,33}$ 将由于 λ_{12} 值的微弱及退磁场 而变得很小.这一点与实验结果符合较好(见图 4). $a_{E,31}$ 可表示为 其中, ${}^{r}s_{ij}$ 和 ${}^{p}d_{ij}$ 分别是压电体的柔性系数和压电系数, ${}^{r}\varepsilon_{kn}$ 是介电系数矩阵. $v = {}^{p}v({}^{p}v + {}^{m}v)$, $m^{p}v$ $m^{m}v$ 分别是磁致伸缩相和压电相的体积. 该理论结果亦 示于图 4(图中的实线). 另外,比较 $a_{E,31}$ 的理论与实 验,发现两者线形及峰值也符合很好,但理论比实验 值要高出许多. 该差异应该归结为层间耦合的不尽 理想. 根据理论和实验曲线可估计出耦合系数 $k \approx$ 0.26. 因此改善层间耦合应该是进一步提高 ME 输 出的一个合理方向. 但 NZFO-PZT 双层膜样品中 ME 效应源于 NZFO 与 PZT 之间相对良好的磁电耦合应 该是可信的.

4.结 论

通过 sol-gel 方法与热压法相结合,我们制备出 具有较高 ME 效应的(Ni_{0.8} Zn_{0.2} Fe₂O₄)epoxy-Pb(Zr, Ti)O₃ 双层膜.在 17.12kAm⁻¹的偏置磁场下,其横向 ME 系数可达 199.6 mV Am⁻².这一较大 ME 效应的 产生应该归结为 NZFO 的独特制备方法和 NZFO 与 PZT 之间相对良好的弹性耦和.由于这一效应是在 室温,低场下得到的,且样品的制备方法简单易行, 成本低廉,所以更具实用意义.

- [1] Landau L D, Lifshitz E M 1960 Electrodynamics of Continuous Media(Pergamon, Oxford)p119
- [2] Astrov D N 1961 Sov. Phys. JETP 13 729
- [3] Rado G T , Folen V J 1961 Phys. Rev. Lett. 7 310
 Foner S , Hanabusa M 1963 J. Appl. Phys. 34 1246
- [4] AI 'shin B I, Astrov D N 1963 Sov. Phys. JEPT. 17 809
- [5] Rado G T 1964 Phys. Rev. Lett. 13 335
- [6] Ascher E , Rieder H , Schmid H , Stössel H 1966 J. Appl. Phys. 37 1404
- [7] Santoro R P , Segal D J , Newnham R E 1966 J. Phys. Chem. Solids 27 1192
- [8] Watanabe T , Kohn K 1989 Phase trans . 15 57
- [9] O'Dell T H 1967 Phil. Mag. 16 487
- [10] Krichevtstov B B, Pavlov V V, Pisarev R V, Selitsky A G 1993 Ferroelectrics 161 65
- [11] Schmid H 1973 Int. J. Magn. 4 337
- [12] Suchtelen J van 1972 Philips Res. Rep. 27 28
- [13] Boomgaard J Van den , Terrell D R , Born R A J 1974 J. Mater.

Sci. 9 1705

- [14] Boomgaard J Van den , Run A M J G van , Suchtelen J van 1976 Ferroelectrics 14 727
- [15] Boomgaard J Van den , Born R A J 1978 J. Mater. Sci. 13 1538
- [16] Wan J G , Liu J M , Chand H L W , Choy C L , Wang G H , Nan C W 2003 J. Appl. Phys. 93 9916
- [17] Srinivasan G, DeVreugd C P, Flattery C S, Laietsin V M, Paddubnaya N 2004 Appl. Phys. Lett. 85 2550
- [18] Taylor J A, Reczek S T, Rosen 1995 Am. Ceram. Soc. Bull. 74 91
- [19] Stoppels D 1996 J. Magn. Magn. Mater. 160 323
- [20] Srinivasan G , Rasmussen E T , Hayes R 2003 Phys. Rev. B 67 014418
- [21] Yan S F , Geng J X , Yin L , Zhou E L 2004 J. Magn. Magn. Matet. 277 84
- [22] Li Y , Zhao J P , Han J C 2002 Bull . Mater . Sci . 25 263
- [23] Bichurin M I, Petrov V M, Srinivasan G 2002 J. Appl. Phys. 92 7681

Magnetoelectric effect in bilayers of (Ni_{0.8}Zn_{0.2}Fe₂O₄)_{epoxy}-PZT*

Zhang Ru¹) Wang Miao¹) Zhang Ning¹[†] Srinivasan G¹⁽²⁾

Magnetoelectronic Laboratory, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China)
 2 Methysics Department, Oakland University, Rochester, JM 48309, USA)

(Received 20 October 2005 ; revised manuscript received 11 November 2005)

Abstract

In this paper we discuss the magnetoelectric (ME) effect in bilayers of Nickle Zinc ferrite (NZFO) and lead zirocnate titanate (PZT). The powder of NZFO was prepared by sol-gel technique, then hot-pressed at 900 °C, and sintered at high temperatures. In these bilayers we measured strong magnetoelectric interaction and observed that the transverse ME effect was higher than the longitudinal effect by one order of magnitude, and the ME effect tended to be stronger as the sintering temperature of NZFO increased. When the sintering temperature was increased from 950 °C to 1380 °C, the maximum voltage coefficient of transverse ME effect could change in the range of 25.6 mV Am⁻² $\leq \alpha_E \leq 199.6$ mV Am⁻². Theoretical analysis shows that the ME effect observed in these samples origins from a good magnetoelectric coupling between NZFO and PZT.

Keywords : $\rm Ni_{0.8}\,Zn_{0.2}\,Fe_2\,O_4\,$, PZT , hot-pressing , ME effect PACC : 7550G , 7760 , 7550

^{*} Project supported by National Natural Science Foundation of China (Grant No. 20473038) and the High-Tech Project of Jiangsu Province, China (Grant No. BG-2005401).

[†] E-mail : zhangning@njnu.edu.cn